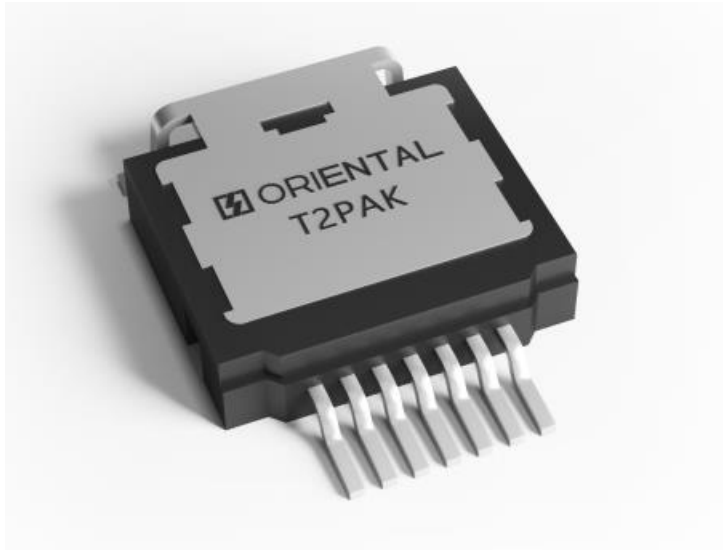
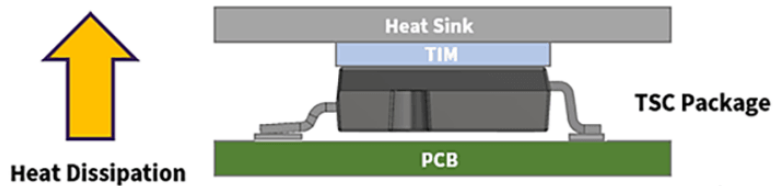


T2PAK 封装 ---SiC/SJ MOSFETs & IGBT

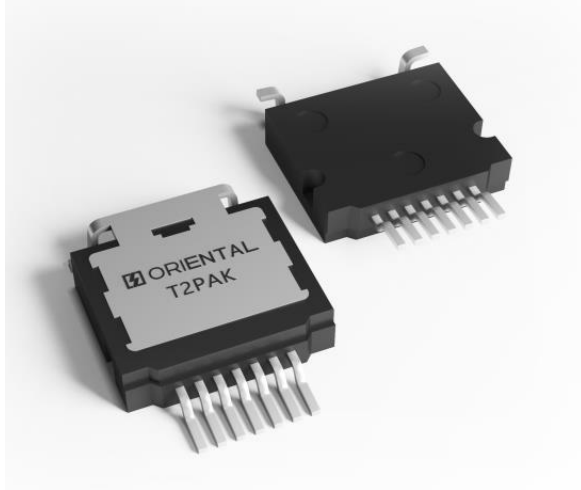
随着电力电子应用的需求日益增长，高电压系统正面临功率密度要求严苛与散热空间受限的双重挑战。为克服这一难题，东微半导体正式面向汽车与工业市场，发布已实现量产、采用 T2PAK 顶部散热封装的器件，旨在为系统设计提供更优的解决方案。



T2PAK 采用顶部冷却式 (TSC) 设计，可提供更高的功率密度、更高效的热管理以及更便捷的装配工艺。这些特性使其成为大功率汽车和工业应用的理想解决方案。



东微半导体推出的碳化硅 MOSFET T2PAK 封装产品，集温度特性稳定、开关速度快与卓越的短路鲁棒性于一身，能够满足日益增长的高功率、高电压工业应用需求。该产品是电动汽车充电桩、光伏逆变器及电机驱动等领域的理想选择。



热性能

- 顶部冷却的 SMD 封装

设计优势

- 开关损耗非常低
- 反向恢复快
- 开关速度快
- 关断损耗不受结温影响
- 体二极管速度快且稳健性佳

主要技术特性

- 卓越的 $R_{DS(on)}$ 温度稳定性
- 优异的栅极电荷及比值
 - 栅极驱动损耗低
 - 对寄生导通的耐受性高

关键应用

- 电动汽车充电基础设施
- 光伏逆变器
- 开关电源
- 不间断电源
- 电机驱动器

